
	<h2 style="color: red;">FCB260N65S3</h2>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> FCB260N65S3
	<b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 650V 260MOHM D2PAK
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FCB260N65S3.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FCB260N65S3
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 650V 260MOHM D2PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 1.2mA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D <sup>2</sup> PAK (TO-263)
Serie	SuperFET® III
Rds On (Max) @ Id, Vgs	260 mOhm @ 6A, 10V
Verlustleistung (max)	90W (Tc)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1010pF @ 400V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	24nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 650V 12A (Tc) 90W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Tc)

FCB260N65S3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FCB260N65S3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FCB260N65S3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FCB260N65S3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FCB22R2J</b> TE Connectivity Passive Product RES 2.20 OHM 2W 5% RADIAL</p>	 <p><b>FCB2R22J</b> TE Connectivity Passive Product RES 0.22 OHM 2W 5% RADIAL</p>	 <p><b>FCB290N80</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 17A D2PAK</p>	 <p><b>FCB290N80</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 17A D2PAK</p>
 <p><b>FCB23R3K</b> TE Connectivity Passive Product RES 3.30 OHM 2W 10% RADIAL</p>	 <p><b>FCB2R47J</b> TE Connectivity Passive Product RES 0.47 OHM 2W 5% RADIAL</p>	 <p><b>FCB24R7J</b> TE Connectivity Passive Product RES 4.70 OHM 2W 5% RADIAL</p>	 <p><b>FCB247RJ</b> TE Connectivity Passive Product RES 47.0 OHM 2W 5% RADIAL</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FCB260N65S3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FCB260N65S3 Datenblatt	FCB260N65S3-Datenblätter	FCB260N65S3 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FCB260N65S3
FCB260N65S3 Electronic	FCB260N65S3-Komponenten	FCB260N65S3-Verteiler	FCB260N65S3-Bild	FCB260N65S3-Teil
FCB260N65S3 Preis	FCB260N65S3 Hersteller	FCB260N65S3 Bild	FCB260N65S3 Aktie	FCB260N65S3 Inventar
FCB260N65S3 Neu	FCB260N65S3 Original	FCB260N65S3 garantiert	FCB260N65S3 RFQ	FCB260N65S3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited